
	<b>FQD9N08TM</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD9N08TM
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FQD9N08TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD9N08TM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD9N08TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	210 mOhm @ 3.7A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 7.4A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)

FQD9N08TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD9N08TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD9N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQD9N08TM E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQD8P10TM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD8P10TM_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD8P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FQD9N15</b> Original FQD9N15 Original</p>	 <p><b>FQD9N25TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>
 <p><b>FQD9N08TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD8P10TM_SB82052</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 6.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N25TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD9N08L VB</b> FQD9N08L VB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD9N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD9N08TM-Datenblätter	FQD9N08TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD9N08TM
FQD9N08TM Electronic	FQD9N08TM-Komponenten	FQD9N08TM-Verteiler	FQD9N08TM-Bild
FQD9N08TM Preis	FQD9N08TM Hersteller	FQD9N08TM Bild	FQD9N08TM Aktie
FQD9N08TM Neu	FQD9N08TM Original	FQD9N08TM garantiert	FQD9N08TM RFQ
			FQD9N08TM-Teil
			FQD9N08TM Inventar
			FQD9N08TM Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited